

Сведения ведущей организации

по диссертации Ерушина Евгения Юрьевича «Лучевая стойкость и нелинейно-оптические характеристики кристаллов бариевых халькогенидов» по специальности 1.3.6. - «Оптика» на соискание учёной степени физико-математических наук.

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики и атмосфера им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации	ИОА СО РАН
Ведомственная принадлежность	Минобрнауки России
Почтовый индекс, адрес организации	634055, Россия, г. Томск, площадь Академика Зуева, 1
Веб-сайт	https://www.iao.ru/
телефон	(3822) 492-738
Адрес электронной почты	contact@iao.ru
Фамилия Имя Отчество Ученая степень, ученое звание руководителя ведущей организации	д.ф.-м.н., чл.-к. РАН Пташник Игорь Васильевич

Список основных публикаций сотрудников организации по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15):

1	Tunable optical parametric oscillator based on ZnGeP ₂ crystal for greenhouse gas remote sensing systems / N.N. Yudin, M.M. Zinoviev, S.N. Podzyvalov, V.S. Kuznetsov [et al] // Frontiers in Physics. – 2024. – Vol. 12. – Art. num. 1404504. DOI: 10.3389/fphy.2024.1404504
2	Experimental Investigation of Laser Damage Limit for ZPG Infrared Single Crystal Using Deep Magnetorheological Polishing of Working Surfaces / N.N. Yudin, M.M. Zinovev, E.S. Slyunko, S.N. Podzyvalov [et al] // Crystals. – 2024. – Vol. 14, № 1. – Art. num. 32. DOI: 10.3390/cryst14010032
3	Laser-induced damage threshold of ZnGeP ₂ crystal for (sub)picosecond 1- μ m laser pulse / I.O. Kinyaevskiy, N.N. Yudin, M.M. Zinovev, S.N. Podzyvalov [et al] // Applied Optics. – 2023. – Vol. 62, № 1. – P. 16–20. DOI: 10.1364/AO.475336
4	Laser-Induced Damage Threshold of Single Crystal ZnGeP ₂ at 2.1 μ m: The Effect of Crystal Lattice Quality at Various Pulse Widths and Repetition Rates / N.N. Yudin, M.M. Zinoviev, S.N. Podzyvalov, E.S. Slyunko [et al] // Crystals. – 2022. – Vol. 12, № 5. – Art. num. 652. DOI: 10.3390/cryst12050652

5	Influence of the characteristics of multilayer interference antireflection coatings based on Nb, Si, and Al oxides on the laser induced damage threshold of ZnGeP ₂ Single Crystal / Zinoviev M., Gladkiy V., Moskvichev E., Kinyaevskiy I., Podzyvalov S., Slyunko E., Zhuravleva E., Pfaf A., Yudin N. A., Kulesh M. // Crystals. – 2021. – V.11. – P.1549.
6	Effect of postgrowth processing technology and laser radiation parameters at wavelengths of 2091 and 1064 nm on the laser-induced damage threshold in ZnGeP ₂ single crystal / N.N. Yudin, M.M. Zinoviev, E.V. Zhuravleva, O.L. Antipov [et al] // Quantum Electronics. – 2021. – Vol. 51, № 4. – P. 306–316. DOI: 10.1070/QEL17389
7	Frequency conversion of femtosecond Ti:Sapphire laser pulse into 5–11 μm wavelength range with ZnGeP ₂ , AgGaS ₂ and LiGaS ₂ crystals / I.O. Kinyaevskiy, A.V. Koribut, Ya.V. Grudtsyn, M.V. Ionin, Yu.M. Klimachev, N.N. Yudin, A.A. Ionin // Optics and Laser Technology. – 2025. – Vol. 183. – Art. num. 112270.
8	Band-like Inhomogeneity in Bulk ZnGeP ₂ Crystals, and Composition and Influence on Optical Properties / A. Lysenko, N.N. Yudin, M. Khimich, M. Zinovev, E. Slyunko, S. Podzyvalov, V. Kuznetsov, A. Kalsin, M. Kulesh, H. Baalbaki, et al. // Crystals. – 2025. – Vol. 15. – Art. num. 382. – DOI: 10.3390/cryst15040382.
9	High-temperature CH ₄ sensors based on multilayer Ga ₂ O ₃ /SnO ₂ /Ga ₂ O ₃ thin-film structures with SiO ₂ barrier layers / A.V. Almaev, B.O. Kushnarev, P.A. Yunin, P.M. Korusenko, N.N. Yakovlev, A.V. Koroleva, E.V. Zhizhin, N.N. Yudin // Materials Science and Engineering B. – 2026. – Vol. 332. – Art. num. 119622.
10	Gravity-Field Self-Regulatory Engineering Enables PbIn ₆ Te ₁₀ Nonlinear Optical Crystals Boosting Laser-Induced Damage Threshold / Xiangran Kong, Jingdong Yan, Jin Ren, Guochang Wang, Nikolay Nikolaevich Yudin, Sue Hao, Liwei Dong, Zhiyong Li, Zuotao Lei, Chunhui Yang // Advanced Optical Materials. – 2026. – Vol. 0. – №. e71388.
11	Minimization of Intrinsic Impurity Concentration in ZnGeP ₂ Single Crystals via Directional Recrystallization / Alexander Gribenyukov, Alexey Lysenko, Nikolay Yudin, Elena Slyunko, Sergey Podzyvalov, Mikhail Zinovev, Vladimir Kuznetsov, Andrey Kalsin, Andrei Khudoley, Houssain Baalbaki, Maxim Kulesh, Alexey Olshukov // International Journal of Molecular Sciences. – 2026. – Vol. 27. – №. 4890.
12	The Effect of the Substrate Doping on the Properties of Structure Ga ₂ O ₃ –ZnGeP ₂ / Sergei Podzyvalov, Vera Kalygina, Nikolay Yudin, Elena Slyunko, Mikhail Zinovev, Vladimir Kuznetsov, Leila Shaimerdenova, Houssain Baalbaki // Physica Status Solidi A. – 2025. – Vol. 2400844.

Директор ИОА СО РАН
чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н.



И.В. Пташник